



佛山市国星半导体技术有限公司

FOSHAN NATIONSTAR SEMICONDUCTOR CO., LTD

# 产品规格书 SPECIFICATION

顾客名称 Customer		产品名称 Product	正装小功率芯片
顾客部品号 Customer No.		产品型号 Type	NSS-G0808A1

顾 客 确 认 APPROVED SIGNATURES			

地址：佛山市·南海·广东省新光源产业基地  
 Add: New Lighting Industrial Park, Nanhai District,,Foshan,Guangdong Province,P.R.China  
 电话 (Tel): 086-0757-81807068  
 传真 (Fax): 086-0757-81807066  
 邮编 (Zip): 528226

研 发 中 心 Research & Development Center		
批 准 APPROVE	审 核 CHECK	制 定 DRAW
版本号 (Version NO): A0		
文件发放日期 (Release Date): 2015-08-06		

## 产品特点/ Features:

- (1) 长寿命和高可靠性/ Long lifetime and high reliability
- (2) 高输出光/ High radiant flux
- (3) 100%测试和分拣/ 100% testing and sorting
- (4) 高抗静电能力/ High ESD withstand voltage

## 物理参数/Physical Characteristics:

### (1) 尺寸/Size

芯片尺寸/Chip Size: 08mil×08mil (200μm×200μm)

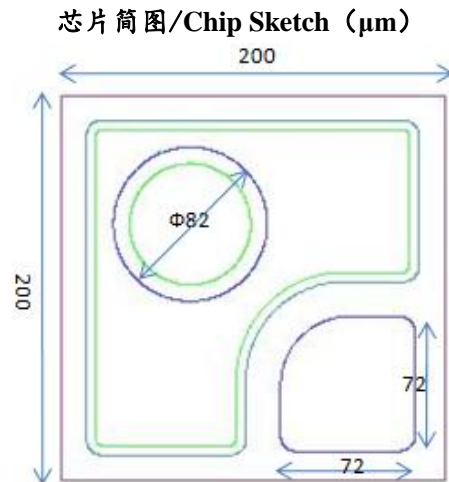
芯片厚度/Chip Thickness: 3.6mil (95±5μm)

电极尺寸/Electrode Size: 正极(P): 82±2μm; 负极(N): 72±2μm

### (2) 电极金属/Electrode Metal: 铝(AL)

### (3) 芯片结构/Structure: InGaN MQW

### (4) 芯片包装/Packaging: 中等粘度蓝膜/Blue tape medium tack

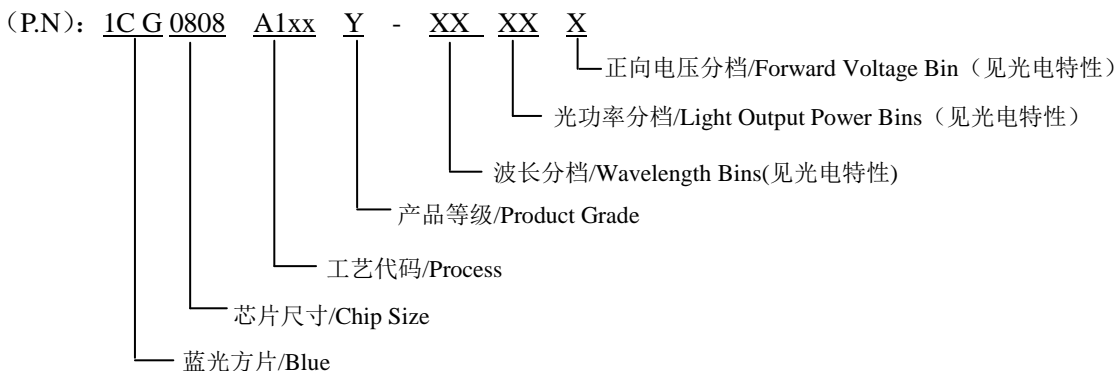


## 客户标签定义/ Customer Label Definition:

NSS-G 0808 A1 -XX XX



## 品号定义/ P.N Definition:



**光电特性/Electro-optical characteristics( $T_c=22^\circ\text{C}$ ):**

参数 Parameter	测试条件 Testing Condition	符合 Symbol	最小值/Min.	最大值/Max.	单位 Unit
反向电流 Reverse Current	$V_f=-10\text{V}$	$I_r$	0	1.0	$\mu\text{A}$
开启电压 Turn-on voltage	$I_f=10\mu\text{A}$	$v_f$	2.1	-	V
正向电压 Forward voltage	$I_f=10\text{mA}$	$V_f$	2.5	3	V
波长 Wavelength(WLD)	$I_f=10\text{mA}$	S4	506	508	nm
		S5	508	510	
		S6	510	512	
		S7	512	514	
		S8	514	516	
		S9	516	518	
		SA	518	520	
		SB	520	522	
		SC	522	524	
		SD	524	526	
		SE	526	528	
		SF	528	530	
		SG	530	532	
		SH	532	534	
SJ	534	536			
光功率 Light Output Power (LOP)	$I_f=10\text{mA}$	K7	2.0	2.2	mW
		K8	2.2	2.4	
		K9	2.4	2.6	
		KA	2.6	2.8	
		KB	2.8	3.0	
		KC	3.0	3.2	
		KD	3.2	3.4	
		KE	3.4	3.7	
		KF	3.7	4.0	
		KG	4.0	4.3	
		KH	4.3	4.6	
KJ	4.6	5.0			
KK	5.0	5.5			

**注解/Notes:**

- (1) 建议使用透明环氧胶或硅胶固晶以获得最佳光输出; /Clear epoxy or silicone is recommended for die attachment to optimize light output;
- (2) 封装工艺温度在 260 度以下, 时间不超过 5 秒; /Assembly processing temperature must not exceed  $260^\circ\text{C}$  for 5sec.;
- (3) 氮化镓二极管是静电敏感器件, 在接触过程中请做好静电防护, 有关信息请参考 MIL-STD-1686A; /GaN LEDs are ESD sensitive, please observe appropriate precautions during handling and processing. For further information please refer to MIL-STD-1686A;
- (4) 所有参数都是在国星半导体测试机上测得的裸晶结果, mW 值误差在  $\pm 10\%$ , WLD 值误差在  $\pm 1\text{nm}$  范围内/All parameters are measured using Nationstar's tester on bare chips, mW and WLD values will vary  $\pm 10\%$ ,  $\pm 1\text{nm}$  respectively;
- (5) 储存湿度及温度范围: 50% ~ 70% &  $18^\circ\text{C}$  ~  $25^\circ\text{C}$ 。 /Humidity and temperature range: 50% ~ 70% &  $18^\circ\text{C}$  ~  $25^\circ\text{C}$ .